

公開シンポジウム 戦略的創造研究推進事業さきがけ

「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究成果報告会

次世代革新的デバイス創成を指向した 物理とテクノロジーの探索

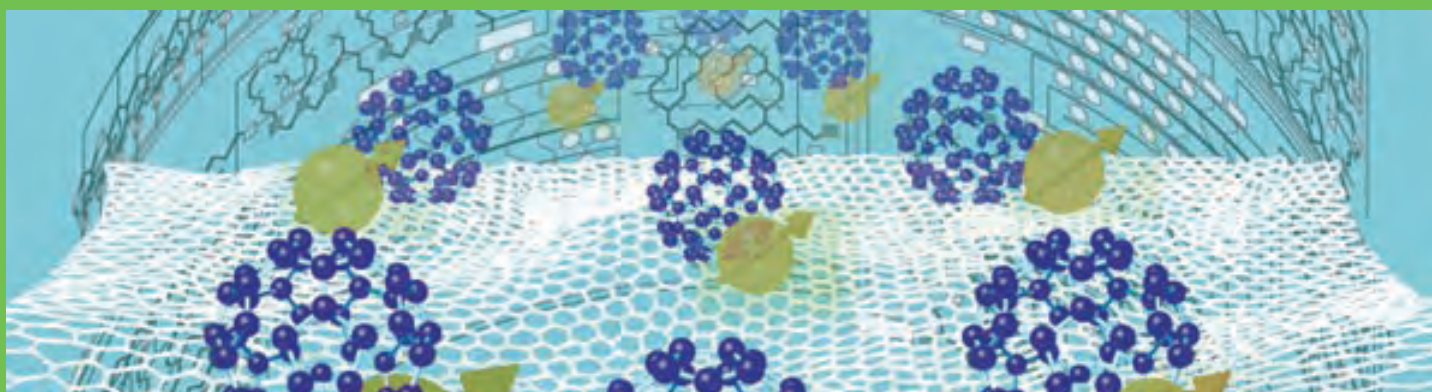
第71回 応用物理学会学術講演会
応用物理学会・JST共同企画シンポジウム

日時：2010年9月15日（水）10：00～17：30

会場：長崎大学文教キャンパス工学部1号館1F-12講義室
長崎市文教町1-14

環境やエネルギー消費に配慮しつつ高速・大容量かつ高度な情報処理・情報蓄積・情報伝達を実現するために、CMOSに代表される既存のシリコンデバイスを超える革新的な次世代デバイスの創成が強く求められています。本シンポジウムでは、将来のデバイス化に向けた新しい物理とテクノロジーの開拓をテーマとして、若手研究者を中心に議論します。対象としてはスピントロニクス材料、強相関材料、ナノカーボン、有機半導体材料などの作製・評価やプロセスの開拓およびデバイス応用を含みます。

なお本シンポジウムは科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業さきがけ「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究領域（研究総括 佐藤勝昭）の第1期の研究成果の発信を兼ねて実施されるもので、JSTと応用物理学会の共同企画で行われます。




社団法人 応用物理学会
独立行政法人 科学技術振興機構(JST)

「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」研究成果報告会

次世代革新的デバイス創成を指向した物理とテクノロジーの探索

プログラム

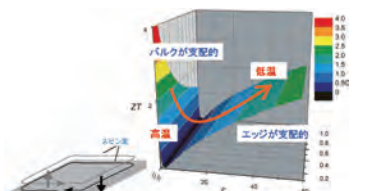
10:00 基調講演
基礎研究が拓くデバイスイノベーション (45分)
 佐藤勝昭
 JSTさきがけ次世代デバイス研究総括



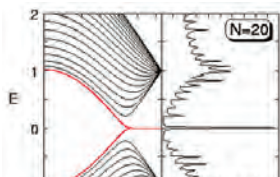
14:35
縦型立体構造デバイス実現に向けた半導体ナノワイヤの研究 (25分)
 深田直樹 NIMS



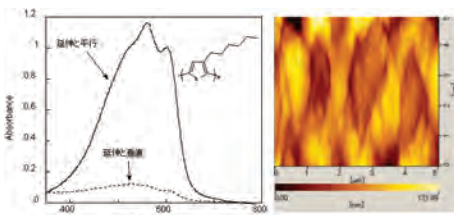
10:45
デバイス応用に向けたスピン流と熱流の結合理論 (25分)
 村上修一 東工大



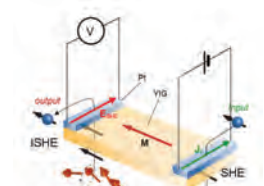
15:00
計算科学手法によるナノカーボン素子の設計と物性予測 (25分)
 若林克法 NIMS



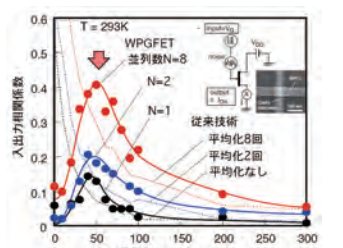
11:10
 π 共役高分子鎖内の超高速電荷輸送を利用した有機トランジスタ (25分)
 安田 剛 NIMS



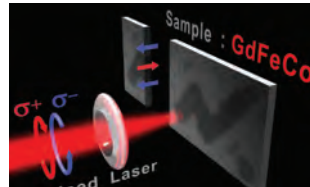
15:25 休憩 (15分)
15:40 誘電体スピントロニクス材料開拓とスピ光機能 (25分)
 齊藤英治 東北大




11:35
確率共鳴を利用した新しい情報処理のためのナノデバイスと集積化 (25分)
 葛西誠也 北大



16:05
フェムト秒パルス・レーザによる超高速スピン制御・計測 (25分)
 塚本 新 日大



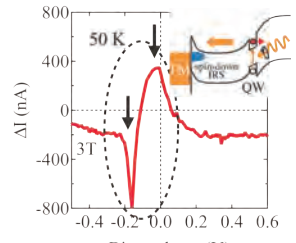
13:00 招待講演
スピン流とスピントロニクス (45分)
 高梨弘毅 東北大
 さきがけ「次世代デバイス」アドバイザー



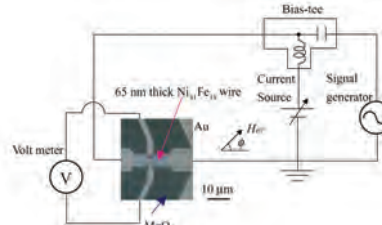
16:30
分子を介したスピン流の制御 (25分)
 白石誠司 阪大



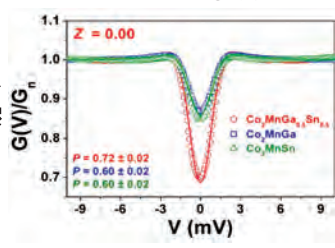
13:45
スピン偏極の外的制御とチューナブルスピン源の創製 (25分)
 谷山智康 東工大



16:55
ナノ磁性体集結群の新奇な磁気特性の究明 (25分)
 山口明啓 慶大



14:10
スピントロニクスデバイス用室温ハーフメタルの探索 (25分)
 高橋有紀子 NIMS



17:20
クロージングトーク (10分)
 栗野祐二 慶大
 さきがけ「次世代デバイス」アドバイザー

